

## 研究簡報

### 在石墨薄膜中所觀察到的一个平行位錯列的分析\*

李日升  关若男  何怡貞  
(中國科學院)

在应用电子显微鏡透射技术直接觀察晶体薄膜中的位錯时,为了进一步了解所觀察到的位錯線的性質,应当在同一視場尽可能地改变成象条件进行觀察,以便充分利用位錯的衍衬效应,提供更多的有助于进行分析的素材。

一般的明場象,往往是在若干衍射光束同时参与成象的条件下得到的。因此,应用現有的只考慮一个強衍射束的衍衬理論对这种象进行分析时,有一定的困难。克服困难的途径有两种<sup>[1]</sup>: (1)把样品傾斜,使某一衍射斑点的強度大大超过其它斑点的強度而在成象时起主导作用; (2)利用暗場技术,即用光闌选定某一較強的衍射斑点来成象。我們采用第二种方法在石墨薄膜中看到了一些有意义的現象。下面是关于一个平行位錯列的分析。

#### 实验結果和分析

石墨薄膜的制备和觀察的方法与以前所报导的相同<sup>[2]</sup>。

图 1, 2, 3 是在一个条状的薄膜試样上对同一視場进行觀察时所看到的現象。图 4 是用来表明薄膜的取向的衍衬象和衍射斑点的示意图。

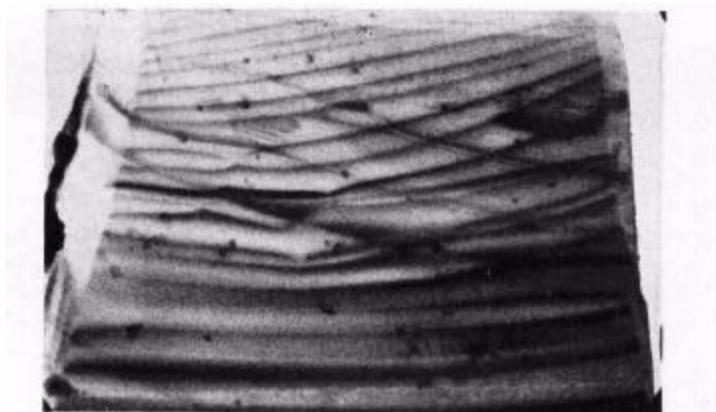


图 1 平行位錯列的明場衍衬象。位錯线都终止在解理台阶处 约×12000

我們首先在明場下进行觀察,看到薄膜的中部有一系列接近平行的线条(图 1)。从照片上可以看出,上部的线条衬度清晰,下部的花样除了有线条的衬度外,在线条之間也

\* 1964 年 7 月 16 日收到。

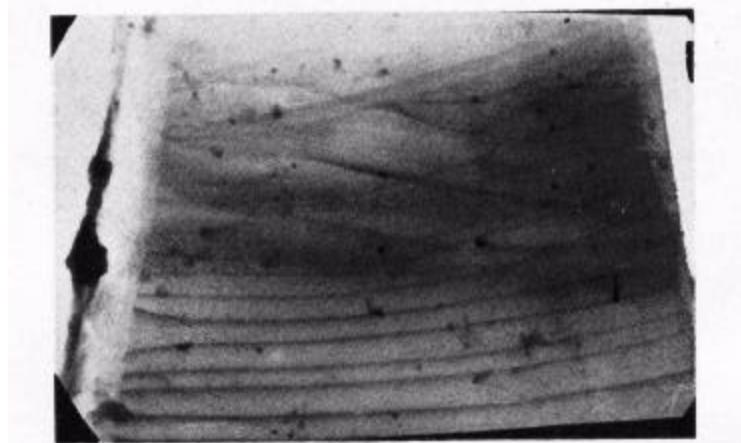


图 2 与图 1 同一视场。把入射电子束倾斜后,位错线的象的衬度有所改变,但位置没有变化

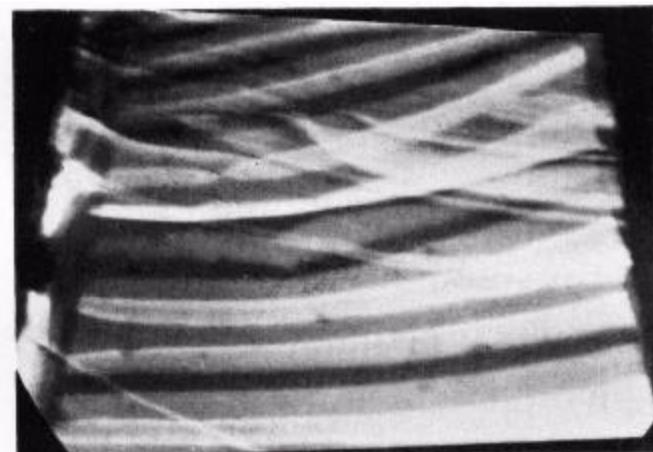


图 3 与图 1, 2 同一视场的( $\bar{1}010$ )暗场象。这里,位错线的象不明显,而出现了以这些线为边界的,具有黑、灰、白三种不同衬度的带

出現一定的衬度。把入射电子束倾斜后,看到上部的线条的衬度大大減弱,而下部的花样則变成清晰的线条(图 2)。仔細地对比图 1 和图 2 可以清楚地看出,在衬度发生变化的时候,线条的位置并沒有改变。这种当倾斜入射电子束时只改变衬度而不改变位置的現象,正是位錯所特有的。因此,可以肯定,这些线条是位錯線的象,它們組成一个接近于平行的位錯列。

为了进一歩了解这些位錯線的性質,我們在衍射花样上选择了較強的( $\bar{1}010$ )斑点进行暗場觀察,并看到了如图 3 所示的由具有三种不同衬度的带所組成的图案。如果用黑、灰、白(浅灰)表示三种不同衬度的带,則带的排列順序从上到下是: 黑、灰、白; 黑、灰、白; 黑、灰、

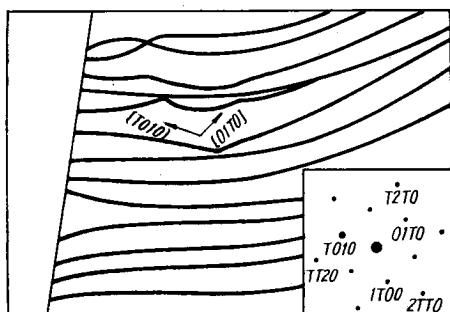


图 4 衍射花样和薄膜的取向

白、灰、白；黑、灰；黑、灰、白、灰、白；黑、灰、白；……。对比明场象和暗场象还可以看出，暗场中带的边界恰为明场中的位错线。我们还用 $\{11\bar{2}0\}$ 型斑点进行暗场观察，并没有看到这种“黑、灰、白”的现象。

前后观察了半小时以上，从所得到的照片可以看出，在整个观察过程中，这些位错线的位置没有发生变化。与此不同，我们在同样照明条件下所观察到的石墨中的某些位错线是比较容易运动的。显然，这一组平行位错线是处于一种相对稳定的状态。

文献[3]中已经指出，平行于薄膜表面的不同层错，在一定的照明条件下，应当显示出不同的均匀衬度。衬度的强弱主要决定于 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{R}$ 之值，其中 $\mathbf{g}$ 是衍射矢量， $\mathbf{R}$ 是层错的位移矢量。当 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{R}$ 等于分数时，层错的衬度可以显示出来；反之，如果 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{R}$ 等于整数（包括零），则不显示出层错的衬度。因此，对于具有六方结构的石墨晶体，在用 $\{10\bar{1}0\}$ 型衍射斑点进行暗场观察时，可以看到具有一定衬度的层错，而用 $\{11\bar{2}0\}$ 型斑点将看不到层错的衬度。此外，对于同一个 $\mathbf{g}$ ，由于 $\mathbf{R}$ 的不同，层错也将显示出不同的衬度。

显然，图3所示的由不同衬度的带所组成的图案，是与文献上所指出的石墨中的平行层错所应有的表现相符合的。因此，可以认为，图中具有灰、白衬度的带，代表两种不同的层错，而黑带代表无层错区。由于层错的边界是不全位错，而暗场中带的边界就是明场中的线，所以在明场下所观察到的位错线都是不全位错。根据带的排列方式，可以用图5所

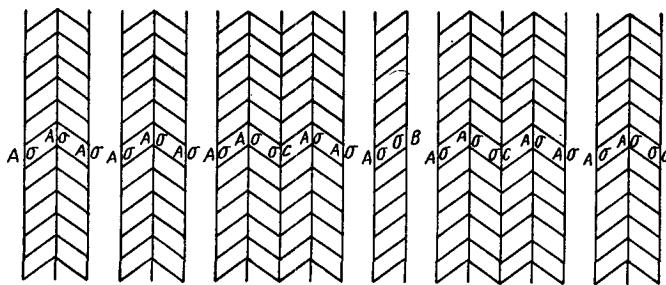


图5 图1—3中平行位错列的示意图。这是由若干三重带、五重带和一个单重带(即扩展位错)所组成的一种特殊的位错组态

示的模型来表示这部分位错的组态。它是由若干三重带、五重带和一个单重带(即扩展位错)所组成的。应用Amelinckx等<sup>[4]</sup>分析石墨中多重带的方法，可以初步定出图5中的不全位错的柏氏矢量，并且看到在五重带中，中间的一个不全位错具有与其他不全位错不同的柏氏矢量。在图3的下部，可以清楚地看到一个五重带中央的不全位错线在左右解理台阶处的表现与其他位错线的表现有显著的差别。这与Amelinckx等<sup>[3]</sup>关于不全位错在解理台阶处的平衡位置的分析结果一致，即具有不同柏氏矢量的不全位错线在解理台阶处的表现不同(详见图6)。因此，可以认为，对于这个五重带所提出的位错模型是合理的。但是对于图3中部的五重带，由于它受到其他层面上的位错线等缺陷的显著干扰，使得进行类似的分析产生了困难。在图7中我们画出了一个三重带和一个五重带的原子堆垛方式的示意图。由图可见，在三重带和五重带中，原子的堆垛方式都有两种，分别和所观察到的灰、白两种带相对应。

在Amelinckx等的工作中，把所有的多重带看作是由基面上的可滑位错所构成的。如

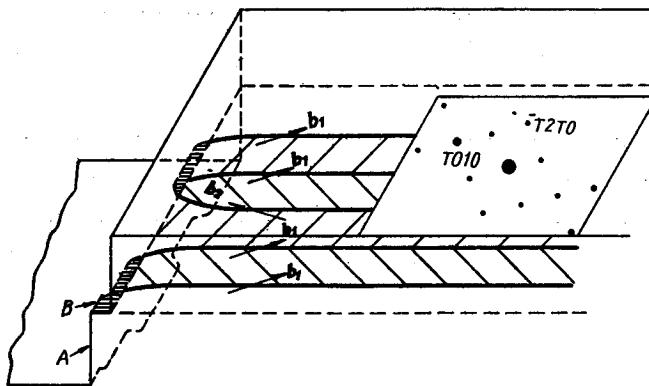


图 6 图 1—3 的下部的五条不全位错线在解理台阶处的行为的示意图。图中 A 表示解理台阶, B 表示位错在解理台阶处所引起的凸出部分 (ledge)。根据位错带在解理台阶处的表现是“张开”或“收缩”, 并参考图 4 中的衍射花样, 可以确定这个五重带中不全位错线的柏氏矢量  
 $A\sigma = b_1$  ( $b_1$  平行于  $[01\bar{1}0]$ ),  $\sigma c = b_2$  ( $b_2$  平行于  $[\bar{1}010]$ )

果考慮到 Fujita 等的观点<sup>[5]</sup>, 石墨中可能有 Frank 型的不可滑位錯, 我們可以提出另一个模型(图 8), 也能說明在一系列不全位錯之間为什么含有三种不同的堆垛方式, 从而同样可以解释了为什么出現黑、灰、白的現象。虽然 Amelinckx 等的工作和我們的其他工作表明, 由可滑位錯組成的多重帶的組态是比較容易出現的, 但是目前我們还缺乏确切的

证据, 能够证明这里的平行位錯列不具有图 8 所示的組态。

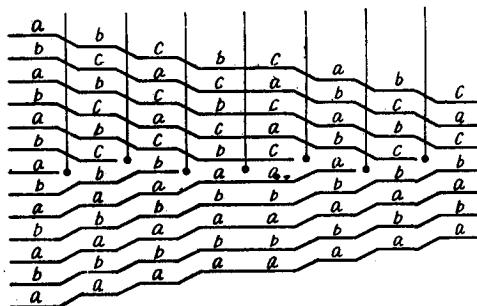
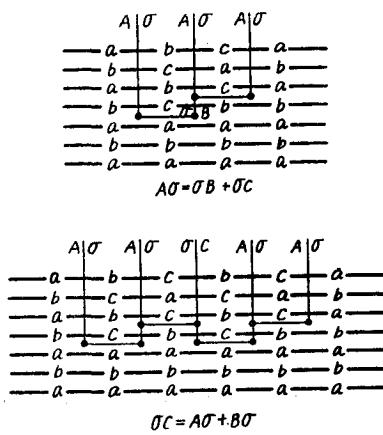


图 7 由 Schockley 位錯所构成的三重带(a)和五重带(b)的截面图(构成的方式不是唯一的)。带的内部的原子堆垛方式有两种, 分别相应于暗场下出现的灰、白两种衬度

图 8 主要由 Frank 位錯所构成的組态的截面图。其中包含的原子堆垛方式有三种, 分别与黑、灰、白三种带相对应

## 討 論

(1) 层錯的衬度还决定于它在薄膜中的深度<sup>[3]</sup>。但是图 3 所示的带的衬度的变化具有一定的規律性, 很难用深度的变化来解释。

(2) 关于不全位錯列不易滑动的原因, 可以从以下三个方面来考虑: a) 晶体中的多重带的运动应当是比较困难的; b) 这些不全位錯綫也可能受解理台阶的釘扎而不易滑动;

c) 如果采用图8的晶体学模型,由于绝大部分不全位错的柏氏矢量都包含着一个与基面垂直的分量,由这些不滑的不全位错所构成的位错列当然是不滑动的。

(3) 本文仅就层错的衬度进行了一般的分析,对层错衬度以及对图1—3中的其他细节(例如层错带的宽度,在某些地方带发生束集等等)的进一步分析,有待于就类似的現象得到更多的觀察材料后再进行討論。

本文的照片是由陈延生同志拍摄的。

### 参 考 文 献

- [1] Pashley, D. W. and Presland, A. E. B., Proceedings of the European Regional Conference on Electron Microscopy (Delft, 1960), Vol. 1 p. 417.
- [2] 关若男、李日升、何怡贞,物理学报,21(1965), 677.
- [3] Amelinckx, S. and Delavignette, P., Direct Observation of Imperfections in Crystals, Interscience, New York, p. 295.
- [4] Delavignette, P. and Amelinckx, S., J. Nuclear Materials, 5 (1962), 17.
- [5] Fujita, F. E. and Izui, K., J. Phys. Soc. (Japan), 16 (1961), 215.